

JP1214038







## PROBE CARD

Patent Number:

JP1214038

Publication date:

1989-08-28

Inventor(s):

NAKAJIMA YASUHARU

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

Application Number: JP19880039925 19880222

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/66; G12B17/02; H05K9/00

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To suppress an oscillation phenomenon to be caused during a measuring operation of an electric characteristic of a semiconductor element and to enhance the measurement accuracy by installing a wave-absorbing material on a fixation member at least near a region where a probe pin has been arranged.

CONSTITUTION: In a probe card 1 where a probe card substrate 11 having a through hole 12, a fixation member 13 arranged at an internal peripheral edge part of the through hole 12 and a probe pin 14 fixed to the probe card substrate 11 via the fixation member 13 are provided, a wave-absorbing material 2 is installed on the fixation member 13 at least near a region where the probe pin 14 has been arranged. For example, the wave-absorbing material composed of a ring-shaped ferrite or the like whose width is narrower than the ring-shaped fixation member 13 is fixed to the rear surface side of the fixation member 13 by using a means such as an adhesive or the like. By this setup, electromagnetic waves due to an oscillation phenomenon caused through a semiconductor element and a measuring system are absorbed by the waveabsorbing material; accordingly, the generation of the oscillation phenomenon is suppressed effectively; an electric characteristic of the semiconductor element can be measured with good accuracy.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVAILABLE COP'

#### ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-214038

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月28日

H 01 L 21/66 G 12 B 17/02 H 05 K 9/00

B-6851-5F 6947-2F

M-7039-5E審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称

プローブカード

②特 題 昭63-39925

②出 願 昭63(1988) 2月22日

**砲発明者 中島** 

庚 暗

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑭代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明相書

1. 発明の名称

プローブカード

2. 特許請求の範囲

(II) 貫通孔を有するプローブカード基板と、前記貫通孔の内周縁部に配設された固定部材と、この固定部材を介して前記プローブカード基板に固定配置されたプローブ針とを備えたプローブカードにおいて、

少なくとも前記プローブ針が配置された領域近 傍の前記固定部材に、電波吸収材を配設したこと を特徴とするプローブカード。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、ウェハ上に形成された半導体素子 の電気的特性を測定する際に用いられるプローブ カードに関する。

(従来の技術)

従来から、この種のプローブカードとして、第 4図(a).(b) に示すような構成のものが知られて いる。このプローブカード10は、プローブカード 基板11と、この基板11に形成された貫通孔12の内 周緑郎に配設された固定部材13と、半導体素子( 図示していない)に阅定用入出力信号を印加する 複数のプローブ針14とを備えている。

そして、このプローブカード10による半導体素子の電気的特性測定は、つぎのような手順で行われている。

ところで、前記構成のプローブカード10においては、これを用いて半導体素子の電気的特性を選定する際、半導体素子の人力側および出力側のそれぞれに対応するプローブ針14間に存在する客生容量を介して入出力間に高周波成分の帰還がかかってしまうため、発援現象が発生してしまい、この発援現象の影響によって半導体素子の電気的特性を特度よく測定することが極めて困難になってしまうという問題点があった。

この発明は、このような問題点を解決するため になされたものであって、半導体素子の電気的特 性測定時に発生する発振現象を抑制し、測定特度 の向上を図ることができるプローブカードの提供 を目的としている。

「私想 【<del>問題点</del>を解決するための手段】

この発明は、質通孔を有するプローブカード基板と、前記質通孔の内周縁部に配設された固定部材と、この固定部材を介して前記プローブカード

2 を配設した以外の構成については、前述した第 4 図に示す従来例と同様であるから、第 1 図 (a), (b) と同一もしくは相当する部品、部分には同一符号を付している。

このプローブカード1は、貫通孔12を有するプローブカード基板11と、前記貫通孔12の内周縁部に配設されたエポキシ系樹脂などからなる円輪状の固定部材13を介して前記である。そして、近面固定部材13の下面側には、これよりも幅映の円輪状に形成されたフェライトなどの低性材料からなに配設されたで設定によってが投着などでよっての固における符号3はプローブかと変し、これらの固における符号3はプローブかはとを個別に投続する配線である。プローブ針14とを個別に投続する配線である。プローブ針14とを個別に投続する配線である。

ところで、この電波吸収材2の配設位置については固定部材13の下面側に限定されるものではなく、例えば、第2図の変形例で示すように、固定

基板に固定配置されたプローブ針とを値えたプローブカードにおいて、少なくとも前記プローブ針 か配置された領域近傍の前記固定部材に電波吸収 材を配設した構成に特徴を有するものである。

(作用)

上記構成によれば、プローブ針が配置された領域近傍に電波吸収材を配設しているので、この電波吸収材によって半導体業子およびプローブ針などの測定系を通じて発生する発振現象による電磁波が吸収されることになるため、発振現象の発生が有効に抑制され、半導体素子の電気的特性が積度よく測定されることになる。

(実施例)

以下、この発明の実施例を図に基づいて説明する。

第1図(a) は本発明の一実施例に係るプロープカードの構成を示す平面図、第1図(b) はそのBーB線に沿う断面図であり、これらの図における符号1はプローブカード、2は電波吸収材である。なお、このプローブカード1における電波吸収材

部材13の上面側もしくは固定部材13の内周面側(包において、仮想線で示す)に配設されているよい。また、この電波吸収材2は、必ずしもプローブカード基板11の質適孔12を全面的に取り囲むように形成されている必要はなく、少とさ材13に配設するものとしているが、このような歌がでは、成形体としているが、このようなでは、成形体に代えて、初末状の磁性材料からなる違いでは、がないに代えて、初末状の磁性材料からなる違いでは、ないうまでもない。

つぎに、上記構成とされたプローブカード』に よる半導体素子の電気的特性の測定手順を、第3 図の特性測定時の状態を示す機略構成図に基づい て説明する。

まず、プローブカード1のプローブ針14それぞれの位置をウェハ5の表面に形成された半導体素子のパッド6と互いに対応する位置に設定したうえ、これらのプローブ針14の先端側14aをプロー

ブカード基板11の貫通孔12から下方に突出させ、固定部材13を介してプローブカード基板11に固定配置する。つぎに、プローバ(図示していない)を構成するステージで上に被測定用のウェハ5を数置して固定するとともに、このウェハ5と対向する状態で配置されたアフード1をアプローバに装著する。そしてアプロード1をアプローバに装著する。そしてアプロード1のアプローブ計14を所定の被測定用半導体素子のパッド6にそれぞれ投入させ、これらのアコネクタバ子3と配線4とで適じて半導体素子と外部電源や測定機器など(いずれも図表でない)との間で測定用入出力信号の授受を行い、この半導体素子の有する電気的特性を測定する。

ところで、この際、半導体素子の入力側および 出力側のそれぞれに対応するプローブ針14間に存 在する寄生容量を介して入出力間に高周波成分の 帰還がかかって発援現象が発生することになるが、 本実能例においては、少なくともプローブ針14が 配置された領域近傍の固定部材13に電波吸収材 2 が配設されているので、この電波吸収材 2 によっ

第1図ないし第3図は本発明に係り、第1図(a) は本発明の一実施例に係るプローブカードの構成を示す平面図、第1図(b) はそのB-B線に沿う断面図、第2図はその変形例を示す断面図であり、第3図は半導体素子の電気的特性測定時の状態を示す概略構成図である。

また、第4図は従来例に係り、第4図(a) はプローブカードの構成を示す平面図、第4図(b) はそのA-A線に沿う断面図である。

図における符号1はプローブカード、2は電波吸収材、11はプローブカード基板、12は質通孔、13は固定部材、14はプローブ針である。

なお、図中の同一符号は、同一または相当する 郎品、部分を示している。

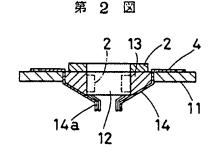
代理人 大岩 增雄

て半導体素子およびプロープ針14などの測定系を 通じて発生する発展現象による電磁波が吸収され ることになり、発展現象の発生が有効に抑制され ることになる。そして、1つの半導体素子の測定 が終了するごとに、プローバのステージを所定距 関すつ移動させることにより、ウェハ5に形成さ れた半導体素子の電気的特性を順次測定する。

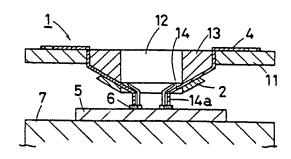
#### (発明の効果)

以上説明したように、この発明に係るプローブカードにおいては、プローブカード基板に形成された関連孔の内周疑問に配設された固定部材の少なくともプローブ針が配置された領域近傍に電波吸収材を配設しているので、この電波吸収材になって半導体素子および測定系を通じて発生する発波現象による電磁波が吸収されることになる。したがって、電波吸収材によって発展現象の発生が有効に抑制されることになる結果、半導体素子における電気的特性の測定特度の向上を図ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

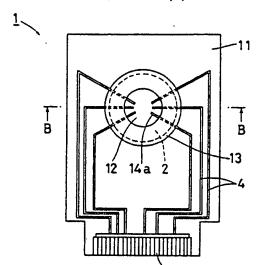


第3図

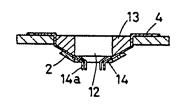


## 特開平1-214038 (4)

### 第 1 図 (a)



第 1 図 (b)



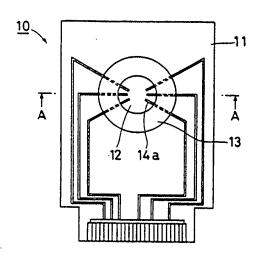
## 第 4 図 (a)

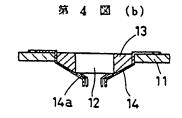
1:プローブカード

11:プローブカード基板

2: 電放吸収材

12: 貫通孔 13: 固定部材 14: プローブ針





# 手続補正書(日発)

昭和63年11月26日

特炸疗及官 股

3 9 9 3 5 55 [3] · ]

1、事件の表示 昭和63年特許願第39925号

2、発明の名称 プローブカード

3、補正をする者 事件との関係 特許出願人

郵便香号 100

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 殊 (601) 三菱花微株式会社 代装者 忠 蛟 守 龊

4、代雅人 郵便番号 100

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 変 電 機 株式会社内

氏 名 (7375) 非理士 大 岩 增 雌 (外2名) (进格先03(213) 3421 特许部)

5、補正命令の日付 白発補正

6、福正により増加する納水項の数

なし

7、稲正の対象

(1)明細古の「宛明の詳細な説明」の個



8、 約正の内容 (1) 明朝世の第6 及第1 0 行目~第1 1 行目に「導 ポペースト」とあるのを「磁性ペースト」と該正す。

以上

BEST AVAILABLE COP'